

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年3月16日(16.03.2023)



(10) 国際公開番号

WO 2023/038036 A1

(51) 国際特許分類:
C03B 20/00 (2006.01) C03C 3/076 (2006.01)
C03C 3/06 (2006.01) C03C 4/00 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2022/033482

(22) 国際出願日: 2022年9月6日(06.09.2022)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2021-146400 2021年9月8日(08.09.2021) JP

(71) 出願人: A G C 株式会社 (AGC INC.) [JP/JP];
〒1008405 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 大和田 知希 (OWADA Tomoki);
〒9630215 福島県郡山市待池台一丁目8番地 A G C
エレクトロニクス株式会社内 Fukushima (JP). 佐々木 寿弥 (SASAKI Kazuya); 〒9630215
福島県郡山市待池台一丁目8番地 A G C
エレクトロニクス株式会社内 Fukushima (JP). 川岸 正寛 (KAWAGISHI Masahiro); 〒9630215
福島県郡山市待池台一丁目8番地 A G C
エレクトロニクス株式会社内 Fukushima (JP). 倉田 智 (KURATA Satoru); 〒1008405 東京
都千代田区丸の内一丁目5番1号 A
G C株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 特許業務法人栄光特許事務所 (EIKOH
PATENT FIRM, P.C.); 〒1050003 東京都港区
西新橋一丁目7番13号 虎ノ門イースト
ビルディング10階 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,

CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP,
KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK,
LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW,
MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE,
PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD,
SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT,
TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS,
MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM,
ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ,
TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,
LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS,
SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,
GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: TiO₂-CONTAINING SILICA GLASS SUBSTRATE

(54) 発明の名称: T i O₂ 含有シリカガラス基板

(57) Abstract: The present invention relates to a TiO₂-containing silica glass substrate that: contains 6.7-12 mass% of TiO₂, expressed as a mass percentage on an oxide basis; has a CTE-slope of 1.40 ppb/K/K or less; and, in at least one main surface and at least one end surface, (A) no striae are observed in a stria evaluation in compliance with JOGIS 11-2008, or (B) the striation intensity corresponds to class A under US military specification MIL-G-174 B.

(57) 要約: 本発明は、酸化物基準の質量百分率表示で6.7~12質量%のT i O₂を含有し、1.40 p p b / K / K 以下の C T E - s l o p e を有し、少なくとも1の主面、及び少なくとも1の端面において、(A) J O G I S - 1 1 (2 0 0 8) に準ずる脈理評価において脈理が観察されない、または(B)脈理の強度が米国ミリタリー規格: M I L - G 1 7 4 B のクラスAに該当する、T i O₂含有シリカガラス基板に関する。



WO 2023/038036 A1